NEW PRODUCT

DDTB (LO-R1) U

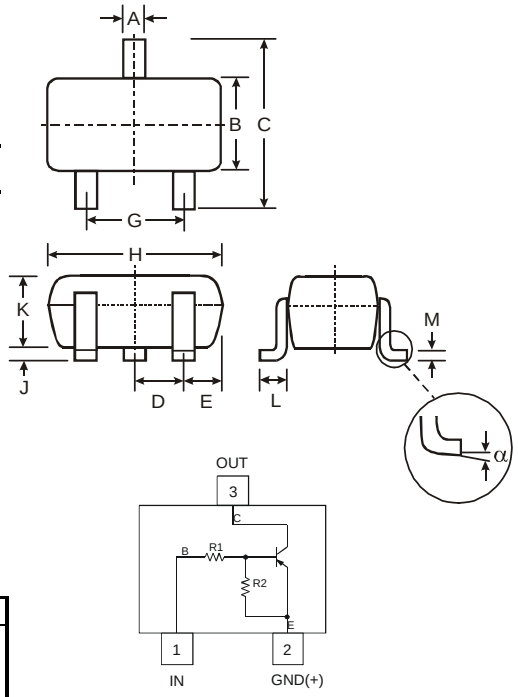
PNP PRE-BIASED 500 mA SURFACE MOUNT TRANSISTOR

Features

- Epitaxial Planar Die Construction
- Complementary NPN Types Available (DDTD)
- Built-In Biasing Resistors
- **Lead Free/RoHS Compliant (Note 2)**
- **"Green" Device (Note 3 & 4)**

Mechanical Data

- Case: SOT-323
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound, Note 4. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Terminal Connections: See Diagram
- Lead Free Plating (Matte Tin Finish annealed over Alloy 42 leadframe)
- Marking Information: See Table Below & Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.006 grams (approximate)



Schematic and Pin Configuration

SOT-323		
Dim	**Min**	**Max**
A	0.25	0.40
B	1.15	1.35
C	2.00	2.20
D	0.65 Nominal	
E	0.30	0.40
G	1.20	1.40
H	1.80	2.20
J	0.0	0.10
K	0.90	1.00
L	0.25	0.40
M	0.10	0.18
α	0°	8°
All Dimensions in mm		

P/N	R1 (NOM)	R2 (NOM)	Type Code
DDTB122LU	0.22KΩ	10KΩ	P75
DDTB142JU	0.47KΩ	10KΩ	P76
DDTB122TU	0.22KΩ	OPEN	P77
DDTB142TU	0.47KΩ	OPEN	P78

Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic		Symbol	Value	Unit
Supply Voltage, (3) to (2)		V_{CC}	-50	V
Input Voltage, (1) to (2)	DDTB122LU DDTB142JU	V_{IN}	+5 to -6 +5 to -6	V
Input Voltage, (2) to (1)	DDTB122TU DDTB142TU	$V_{EBO\ (MAX)}$	-5	V
Output Current	All	I_C	-500	mA
Power Dissipation	(Note 1)	P_d	200	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air	(Note 1)	$R_{\theta JA}$	625	°C/W
Operating and Storage Temperature Range		T_j, T_{STG}	-55 to +150	°C

Notes:
1. Mounted on FR4 PC Board with recommended pad layout at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf.
2. No purposefully added lead.
3. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
4. Product manufactured with Date Code 0627 (week 27, 2006) and newer are built with Green Molding Compound. Product manufactured prior to Date Code 0627 are built with Non-Green Molding Compound and may contain Halogens or Sb2O3 Fire Retardants.

NEW PRODUCT

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified — R1, R2 Types

Characteristic		Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Input Voltage	DDTB122LU DDTB142JU	$V_{I(off)}$	-0.3 -0.3	—	—	V	V_{CC} = -5V, I_O = -100μA
	DDTB122LU DDTB142JU	$V_{I(on)}$	—	—	-2.0 -2.0	V	V_O = -0.3V, I_O = -20mA V_O = -0.3V, I_O = -20mA
Output Voltage		$V_{O(on)}$	—	—	-0.3V	V	I_O/I_I = -50mA/-2.5mA
Input Current	DDTB122LU DDTB142JU	I_I	—	—	-28 -13	mA	V_I = -5V
Output Current		$I_{O(off)}$	—	—	-0.5	μA	V_{CC} = -50V, V_I = 0V
DC Current Gain	DDTB122LU DDTB142JU	G_I	56 56	—	—	—	V_O = -5V, I_O = -50mA
Gain-Bandwidth Product*		f_T	—	200	—	MHz	V_{CE} = -10V, I_E = -5mA, f = 100MHz

* Transistor - For Reference Only

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified — R1 – Only Types

Characteristic		Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Collector-Base Breakdown Voltage		BV_{CBO}	-50	—	—	V	I_C = -50μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage		BV_{CEO}	-40	—	—	V	I_C = -1mA
Emitter-Base Breakdown Voltage	DDTB122TU DDTB142TU	BV_{EBO}	-5	—	—	V	I_E = -50μA I_E = -50μA
Collector Cutoff Current		I_{CBO}	—	—	-0.5	μA	V_{CB} = -50V
Emitter Cutoff Current	DDTB122TU DDTB142TU	I_{EBO}	— —	—	-0.5 -0.5	μA	V_{EB} = -4V
Collector-Emitter Saturation Voltage		$V_{CE(sat)}$	—	—	-0.3	V	I_C = -50mA, I_B = -2.5mA
DC Current Transfer Ratio	DDTB122TU DDTB142TU	h_{FE}	100 100	250 250	600 600	—	I_C = -5mA, V_{CE} = -5V
Gain-Bandwidth Product*		f_T	—	200	—	MHz	V_{CE} = -10V, I_E = 5mA, f = 100MHz

* Transistor - For Reference Only

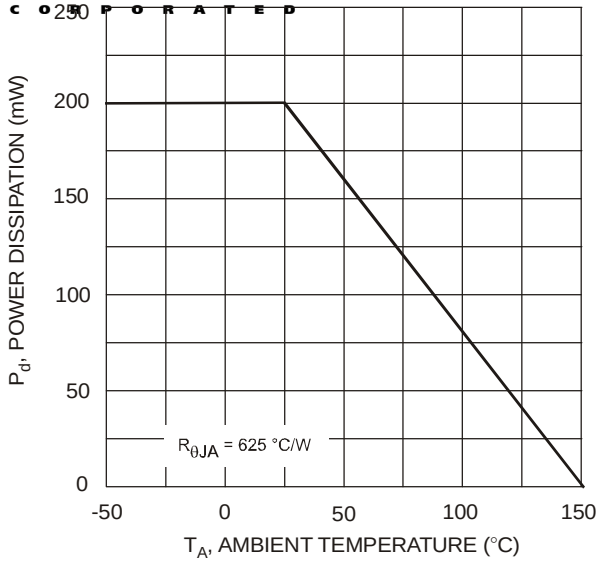


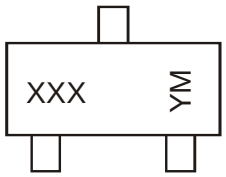
Fig. 1 Power Derating Curve

Ordering Information (Note 4 & 5)

Device	Packaging	Shipping
DDTB122LU-7-F	SOT-323	3000/Tape & Reel
DDTB142JU-7-F	SOT-323	3000/Tape & Reel
DDTB122TU-7-F	SOT-323	3000/Tape & Reel
DDTB142TU-7-F	SOT-323	3000/Tape & Reel

Notes: 5. For packaging details, go to our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf.

Marking Information



XXX = Product Type Marking Code (See Page 1)
YM = Date Code Marking
Y = Year ex: T = 2006
M = Month ex: 9 = September

Date Code Key

Year	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Code	T	U	V	W	X	Y	Z

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

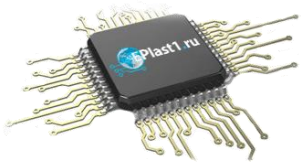
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.